

不揮発性メモリ技術の最前線 - スピンから相変化型、抵抗変化型、 強誘電体まで本音で議論

日時：2020 年 3 月 **13 日 (金)** 13:30 ~

膨大なデータを取り扱う IoT 社会において、高性能なメモリ開発は喫緊の課題となっています。本シンポジウムでは、スピントロニクスを基盤としたメモリである MRAM, STT-RAM, SOT-RAM をはじめ、ReRAM、相変化メモリや強誘電体メモリなどの競合する不揮発性メモリ技術も対象とし、メモリ開発の動向や最先端の技術、今後の展望について本音で議論します。

招待講演者

池川 純夫 (Everspin Technologies, Inc.) :

MRAM' s journey from specialty to mainstream memory

細見 政功 (ソニー) :

STT-MRAM の技術開発と製品化について

塩川 陽平 (TDK) :

スピン軌道トルクを用いたスピン流型磁気メモリの書き込み特性

與田 博明 (YODA-S 株式会社) :

STT-MRAM に続く新規スピントロニクスメモリ SOT-MRAM、
VoCSM とその In-memory computing への応用

富永 淳二 (産総研) :

市場拡大が進む相変化メモリ

— 結晶・アモルファス相転移からトポロジカルなスピン応用へ —

栗村 聡資 (パナソニック) :

抵抗変化型不揮発性メモリ ReRAM のデバイス技術と次世代アプリへの展開

竹内健 (中央大学) :

FeFET を用いたニューロモルフィック・コンピューティング

企画：応用物理学会スピントロニクス研究会 <https://annex.jsap.or.jp/spintro/>

世話人： 関 剛斎 (東北大)、小野 輝男 (京大)、揖場 聡 (産総研)、湯浅 裕美 (九大)、
高橋 茂樹 (サムスン)、中根 了昌 (東大)、柳原 英人 (筑波大)